

トランジスタ

2SA748

2SA748

シリコン PNP エピタキシャルプレーナ形 / Si PNP Epitaxial Planar

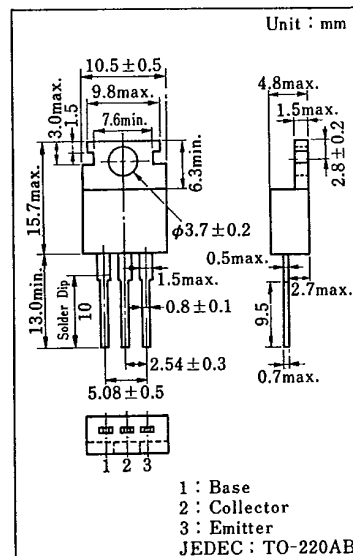
中出力電力増幅用 / Medium Power Amplifier
 2SC1398 とコンプリメンタリ / Complementary Pair with
 2SC1398

■ 特徴 / Features

- コレクタ損失 P_c が大きい。 / Large P_c
- 2SC1398 とコンプリメンタリペアで出力 10 W が得られます。 / 10 W output in complementary pair with 2SC1398

■ 絶対最大定格 / Absolute Maximum Ratings ($T_a = 25^\circ\text{C}$)

Item	Symbol	Value	Unit
コレクタ・ベース電圧	$-V_{CBO}$	70	V
コレクタ・エミッタ電圧	$-V_{CEO}$	50	V
エミッタ・ベース電圧	$-V_{EBO}$	5	V
せん頭コレクタ電流	$-I_{CP}$	3	A
コレクタ電流	$-I_C$	2	A
コレクタ損失 ($T_c = 25^\circ\text{C}$)	P_c	15	W
接合部温度	T_j	150	$^\circ\text{C}$
保存温度	T_{stg}	-55 ~ +150	$^\circ\text{C}$



■ 電気的特性 / Electrical Characteristics ($T_a = 25^\circ\text{C}$)

Item	Symbol	Condition	min.	typ.	max.	Unit
コレクタしゃ断電流	$-I_{CBO}$	$-V_{CB} = 40\text{ V}, I_E = 0$			1	μA
	$-I_{CEO}$	$-V_{CE} = 20\text{ V}, I_B = 0$			100	μA
コレクタ・ベース電圧	$-V_{CBO}$	$-I_C = 1\text{ mA}, I_E = 0$	70			V
コレクタ・エミッタ電圧	$-V_{CEO}$	$-I_C = 10\text{ mA}, I_B = 0$	50			V
エミッタしゃ断電流	$-I_{EBO}$	$-V_{EB} = 5\text{ V}, I_C = 0$			100	μA
直流電流増幅率	h_{FE1}	$-V_{CE} = 5\text{ V}, -I_C = 100\text{ mA}$	30			
	h_{FE2}^*	$-V_{CE} = 5\text{ V}, -I_C = 1\text{ A}$	50	130	220	
コレクタ・エミッタ飽和電圧	$-V_{CE(sat)}$	$-I_C = 1\text{ A}, -I_B = 100\text{ mA}$		0.6	1.0	V
ベース・エミッタ飽和電圧	$-V_{BE(sat)}$	$-I_C = 2\text{ A}, -I_B = 200\text{ mA}$		1.0	1.5	V
トランジション周波数	f_T	$-V_{CE} = 5\text{ V}, -I_C = 500\text{ mA}$		120		MHz

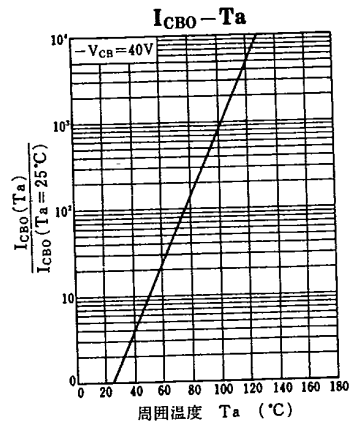
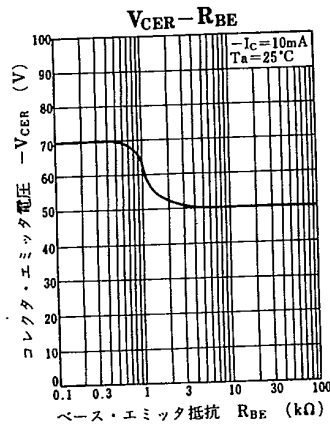
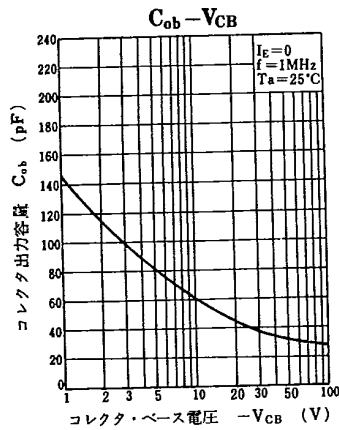
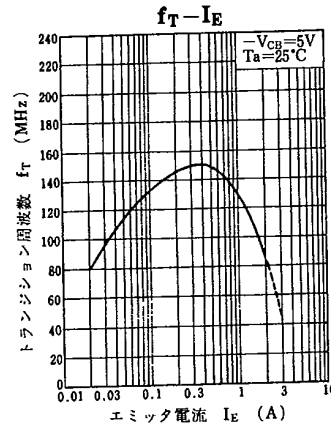
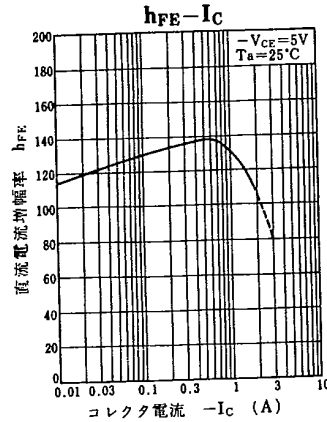
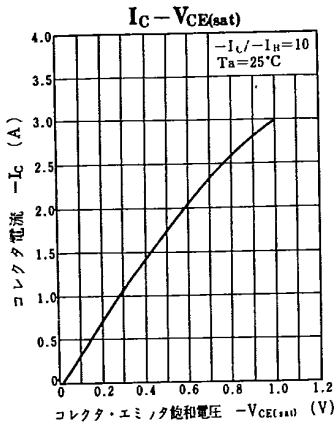
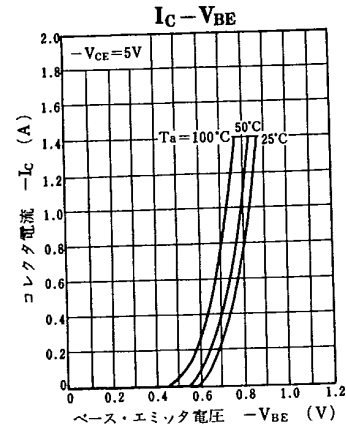
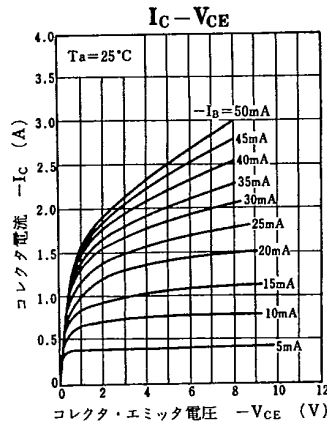
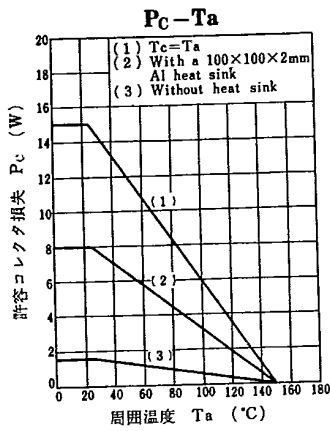
* h_{FE2} ランク分類 / h_{FE2} Classifications

Class	P	Q	R
h_{FE2}	50~100	80~160	120~220

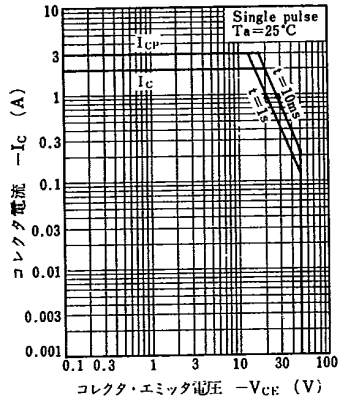
トランジスタ

T-33-17

2SA748



安全動作領域 ASO



$R_{th}(t) - t$

